蛍光体の新規合成法 ―ナノから単結晶まで―

新潟大学 大学院自然科学研究科

山梨 遼太, 渋田 裕介, 戸田 健司

Novel synthesis methods for nano-sized and single crystal phosphors

Ryota Yamanashi, Yusuke Shibuta, Kenji Toda

Graduate School and Science and Technology, Niigata University

1. はじめに

蛍光体はその用途によって求められる形態が 異なっており,用途に適した合成プロセスの開 発や改良は極めて重要である。本稿では当研究 室が開発した二種類の物質拡散を制御する低温 および高温での蛍光体の新規合成法を紹介す る。

Water-assisted solid state reaction (WASSR) 法を用いたナノ蛍光体の 合成

溶液法は均一溶液を出発源として材料合成を 行うため、均一な材料組織をもつセラミックス が容易に得られるということが一般的なイメー ジである。しかしながら、溶液からの核発生を

〒 950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐二の町 8050 TEL 025-262-6771 FAX 025-262-6771 E-mail: ktoda@eng.niigata-u.ac.jp 厳密に制御しなければ均質かつ均一な固体粒子 は得られない,さらに多成分系では均一な溶液 を得ることすら困難であり,合成プロセスの煩 雑化や製造コストの増大が避けられない^[14]。こ のことから,簡便にナノ蛍光体合成が可能な手 法の開発は重要な研究課題である。これに対し て、当研究室では新規な低温合成法:WASSR (Water-Assisted Solid State Reaction)法を開 発した^[5]。図1にWASSR法の合成プロセスを 示す。秤量した原料に対して目的生成物の10



図1 WASSR 法の合成プロセス

NEW GLASS Vol. 33 No. 125 2018

wt%に相当する水を加えて混合を行った後. (a) 25 ℃で静置. (b) 水蒸気雰囲気下において 25 ℃ - 80 ℃で加熱または、(c) 密閉容器を用い て 80 - 220 ℃で加熱するいずれかの処理を行う のみである。WASSR 法により合成された蛍光 体の粒子径は100 nm 以下であることが観察さ れており. これは. その合成温度が 25 - 220 ℃ の極めて低温であることから、粒子成長が大幅 に抑制されていると考えられる。表1に WASSR 法により合成に成功した蛍光体の一覧 を示す^[6-9]。表1に示すように WASSR 法では 酸化物のみならず、塩化物も合成可能であるほ か.発光イオンとして使用する賦活剤(Eu³⁺や Ce³⁺等)も同様に反応しており、適用できる範 囲が広い。溶解が起きていないので、原料物質 は水に可溶でなくともよく、 量産性から見ても

Starting materials	Obtained material	Condition
$A_2CO_3+V_2O_5 (A = Rb, Cs)$	$A VO_3$	25°C, 1 min
$Rb_2CO_3+V_2O_5\\$	$Rb_3V_5O_{14}\\$	80°C, 6 h
$Y_2O_3+V_2O_5+\!Eu_2O_3$	YVO4:Eu3+	80°C, 24 h
$Ca(OH)_2 + V_2O_5$	CaV_2O_6	80°C, 24 h
$KCl + MnCl_2 \cdot 4H_2O$	KMnCl ₃	80°C, 24 h
$Na_2CO_3 + Eu_2O_3 + MoO_3 \\$	NaEu(MoO ₄) ₂	80°C, 48 h
$Mg(OH)_2 + V_2O_5$	$MgV_2O_6 \boldsymbol{\cdot} 2H_2O$	80°C, 96 h
$\begin{array}{l} La(NO_3)_3 \mathrel{\scriptstyle\bullet} 6H_2O + NH_4H_2PO_4 + \\ CeCl_3 \mathrel{\scriptstyle\bullet} 7H_2O + TbCl_3 \mathrel{\scriptstyle\bullet} 6H_2O \end{array}$	LaPO ₄ :Ce ³⁺ , Tb ³⁺	100°C, 6 h
$Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O + Eu_2O_3$ + SiO ₂ (amorphous)	Ba ₂ SiO ₄ :Eu ²⁺	220°C, 24 h
$CsCl + CaCl_2 + EuCl_3 \cdot 6H_2O$	CsCaCl3:Eu2+	220°C, 12 h

表1 WASSR 法を用いて合成した蛍光体

低コストである有望な合成法と言える。本稿で は. WASSR 法により合成に成功している蛍光 体の中から、 青色蛍光体 CsCaCl₂Eu²⁺ について 詳細に示す。

図2(a) に WASSR 法により合成した青色 蛍光体CsCaCl₃:Eu²⁺の走査型電子顕微鏡 (SEM) 画像を示す。得られた粒子径は 50 nm 以下と非常に小さく、ポリマーやガラス中に分 散させた際、可視光の散乱が抑制され、透明性 が失われないことが期待できる。図2(b) に WASSR法により合成した青色蛍光体 CsCaCl₂:Eu²⁺の励起 – 発光スペクトルを示す。 WASSR 法により得られた CsCaCl₃:Eu²⁺は Eu²⁺の4f-5d 遷移によって300-400 nmの紫外 光領域を幅広く吸収し. 436 nm に最大発光 ピークを持つ青色発光を示した。これは既に報 告されている励起 - 発光スペクトルと一致して いる。また、WASSR法により得られた CsCaCl₃:Eu²⁺の発光強度は市販されている青色 蛍光体 BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺と同等の発光強度を 示している。一般的にナノ蛍光体はマイクロ オーダーの蛍光体に比べて、表面欠陥の割合が 増加することから発光強度が著しく低下する が、この結果から WASSR 法を用いて合成され るナノ蛍光体は表面欠陥の少ないことが示唆さ れる [10]。



400 500 Wavelength / nm

ΡI

CsCaCl₃:Eu²⁺

600

--- BAM

WASSR 法により合成した CsCaCl₃:Eu²⁺ (a) SEM 画像 (b) 励起・発光スペクトル (実線) および市販青色蛍光 図2 体 BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺ (BAM)の発光スペクトル(破線)

(a)

3. 集光炉を用いた溶融急冷合成法によ る透明蛍光体の合成

白色 LED に用いる蛍光体を分散させる一般 的な材料はシリコーン樹脂であるが、今後の青 色 LED およびレーザーの出力増加により劣化 する問題が懸念されている。そこで、 蛍光体粉 末をガラス相中に分散させた蛍光体封止ガラス (Phosphor in Glass: PiG)の研究が近年盛んに 行われている^[11-12]。蛍光体封止ガラスの作製プ ロセスは、予め合成したガラスを一度粉砕し、 そのガラスと蛍光体粉末を混合後に焼成するこ とが一般的であるが、 蛍光体(特に窒化物蛍光 体)とガラスが反応し、劣化するという問題が 起こっている。当研究室は集光炉による溶融急 冷合成法を提案し、これまでに蛍光体粉末およ びガラス蛍光体を合成してきた^[13-17]。集光炉の 模式図を図3に示す。本集光炉とは、キセノン アークランプ光をアルミニウム楕円ミラーで一 点に集光させることにより粉末試料を急速に加 熱溶融することができ、銅製試料台の下部を冷 却水が流れているため急冷が可能である。キセ ノンアークランプは太陽光に類似のスペクトル を持つことから、原料の吸収波長にあまり依存 せずに集光部を約2000℃程度まで短時間で上 昇させることが可能である。加えて、炉内をガ ス置換により還元雰囲気に変更できるため、還 元雰囲気下での焼成を必要とする Eu²⁺ や Ce³⁺



を発光イオンとする希土類蛍光体の合成が可能 である。溶融時には均一なメルトが得られ,急 冷することから発光イオンは均一に分散してい る。

本稿では、集光炉を用いた溶融急冷合成法に より Ba₃Al (PO₄) ₃:Eu²⁺ 単結晶とガラス相のコ ンポジットを作製した結果を紹介する。図4 (a) に集光炉を用いて合成した Ba₂Al (PO₄) ₃:Eu²⁺ 単結晶の励起 – 発光スペクトルを示す。 得られた Ba₃Al (PO₄) ₃:Eu²⁺ 単結晶は 425 nm の 青色光励起において、 Eu²⁺の 4f-5d 遷移に起 因する幅広い発光を 500-700 nm の可視光領域 に示した。急冷で得られた Ba₃Al (PO₄) ₃:Eu²⁺ 単結晶中に BaO-0.5Al₂O₃-0.5P₂O₅ ガラス相が分 散し、図4(b)に示すように高い透明性を持つ ことが観察された。本単結晶蛍光体は、イオン 半径が大きく異なる Baと Al が同一サイトを 占めるという結晶学的な常識に反した構造を 持っており、固相反応では得られない進安定相 である。我々は集光炉による単結晶 – ガラス複 合蛍光体の合成メカニズムを以下のように考え ている。 試料は約2000℃に加熱されることで溶 融し、温度が最も低い試料台との接触点におい てのみ Ba₃Al (PO₄) ::Eu²⁺の種結晶が生成する。 一般的な安定相であれば、核発生は多くの部分 で起こり. 最終生成物は多結晶の焼結体もしく はガラスとなる。今回の急冷では少数の核から 溶融塩中における各イオンの拡散により急激な



図4 集光炉による溶融法を用いて合成した Ba₃AlPO₄:Eu²⁺ガラス蛍光体 (a) 励起 – 発光ス ペクトル (b) 蛍光灯下での写真

NEW GLASS Vol. 33 No. 125 2018

成長が起こるため,単結晶が得られたと考えて いる。

4. まとめ

当研究室が開発した蛍光体の新規合成法であ る WASSR 法と集光炉を用いた溶融急冷合成 法を紹介した。これまでに,WASSR 法では結 晶自身が発光する蛍光体に限らず,結晶に Eu²⁺ や Ce³⁺等を賦活した希土類蛍光体の合成に成 功しており,いずれも得られる粒子径は 100 nm 以下であることを確認している。WASSR 法は 適用可能な原料が幅広く,溶液法と比較して合 成プロセスが非常に簡便であるため,低コスト でのナノ粒子合成が期待できる。

集光炉を用いた溶融急冷合成では Ba₃Al (PO₄)₃:Eu²⁺単結晶蛍光体とそのガラス相のコ ンポジットを約 30 秒という極めて短い時間で 合成することに成功した。一般的に蛍光体をガ ラス中に分散させる際,作製したガラスを一度 粉砕し,蛍光体粉末とガラスを混合後に焼成す るプロセスを経由するが,集光炉を用いた溶融 急冷合成は同時に蛍光体相とガラス相が得られ ているため,簡便なガラス蛍光体の合成手法と いえる。また,これまでにガラス自身が発光を 示す 0.4CaO-0.1BO₁₅-0.5SiO₂:Eu²⁺蛍光ガラスの 合成にも成功しており,この発光性ガラスを用 いることで蛍光体粉末の発光が乏しい波長領域 を補った色純度の高い蛍光体封止ガラスへの展 開が期待される。

参考文献

- [1] Y. Hakuta, K. Seino, H. Ura, T. Adschiri, H. Takizawa and K. Arai, J. Mater. Chem., 9, 2671-2674 (1999).
- [2] M. Yang, H. You, K. Liu, Y. Zheng, N. Guo and H. Zhang, *Inorg. Chem.*, 49, 4996-5002 (2010).
- [3] R. P. Rao, J. Electrochem. Soc., 143, 188-197 (1996).

- [4] G. Blasse and A. Bril, Appl. Phys. Lett., 11, 53-55 (1967).
- [5] 戸田健司, 佐藤峰夫, 上松和義, 石垣雅:特開 2011-16670 (P2011-16670A).
- [6] K. Toda, S. W. Kim, T. Hasegawa, M. Watanabe, T. Kaneko, A. Toda, A. Itadani, M. Sato, K. Uematsu, T. Ishigaki, J. Koide, M. Toda. Y. Kudo, T. Masaki and D. H. Yoon, *Key Eng. Mater.*, 690, 268-271 (2015).
- [7] S. W. Kim, T. Hasegawa, M. Watanabe, K. Sugimoto, Y. Saito, K. Uematsu, K. Toda and M. Sato, *Dyes Pigs.*, 136, 219-223 (2017).
- [8] S. W. Kim, Y. Abe, M. Watanabe, T. Hasegawa, M. Muto, A. Toda, T. Ishigaki, K. Uematsu, K. Toda, M. Sato, E. Kawakami, J. Koide, M. Toda, Y. Kudo, T. Masui, T. Masaki and D. H. Yoon, *Dyes Pigs.*, 145, 339-344 (2017).
- [9] T. Hasegawa, S. W. Kim, Y. Abe, M. Muto, M. Watanabe, T. Kaneko, K. Uematsu, T. Ishigaki, K. Toda, M. Sato, J. Koide, M. Toda and Y. Kudo, *RSC Adv.*, 7, 25089-25094 (2017).
- [10] F. Wang, J. Wang and X. Liu, Angew. Chem., 122, 7618-7622 (2010).
- [11] R. Zhang, H. Lin, Y. Yu, D. Chen, J. Xu and Y. Wang, *Laser Photon. Rev.*, 8, 158-164 (2014).
- [12] Y. K. Lee, J. S. Lee, J. Heo, W. B. Im and W. J. Chung, Opt. Lett., 37, 3276-3278 (2012).
- [13] T. Ishigaki, K. Toda, T. Watanabe, N. Sakamoto, N. Matsushita, M. Yoshimura, *J. Mater. Sci.*, 43, 4749-4752 (2008).
- [14] T. Ishigaki, M. Yoshimura, N. Matsushita, K. Uematsu, K. Toda and M. Sato, J. Eur. Ceram. Soc., 30, 165-169 (2010).
- [15] T. Ishigaki, K. Toda, M. Yoshimura, K. Uematsu and M. Sato, *Sci. Adv. Mater.*, 12, 1-4 (2011).
- [16] S. W. Kim, T. Hasegawa, T. Ishigaki, K. Uematsu, K. Toda and M. Sato, *Solid State Lett.*, 2(12), 49 (2013).
- [17] S. W. Kim, T. Hasegawa, M. Inoue, T. Ishigaki, K. Uematsu, K. Toda and M. Sato, *J. Ceram. Soc. Jpn.*, 122, 452-455 (2014).